

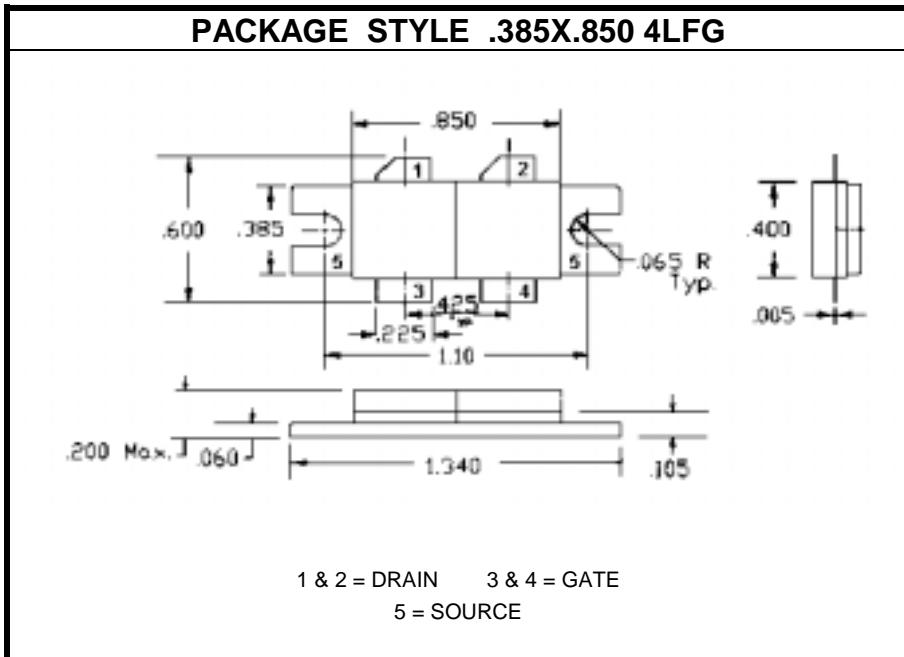
RF FIELD-EFFECT POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:

The **ASI MRF151G** is a Dual Common Source N-Channel Enhancement-Mode MOSFET RF Power Transistor, Designed for 175 MHz, 300 W Transmitter and Amplifier Applications.

MAXIMUM RATINGS

I_D	40 A
V_{DSS}	125 V
V_{GS}	± 40 V
P_{DISS}	500 W @ $T_C = 25$ °C
T_J	-65 °C to +200 °C
T_{STG}	-65 °C to +150 °C
θ_{JC}	0.35 °C/W



CHARACTERISTICS $T_C = 25$ °C

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MINIMUM	TYPICAL	MAXIMUM	UNITS
BV_{DSS}	$I_D = 100$ mA	125			V
I_{DSS}	$V_{DS} = 50$ V $V_{GS} = 0$ V			5.0	mA
I_{GSS}	$V_{DS} = 0$ V $V_{GS} = 20$ V			1.0	µA
$V_{GS(th)}$	$I_D = 100$ mA $V_{DS} = 10$ V	1.0		5.0	V
$V_{DS(on)}$	$I_D = 10$ A $V_{GS} = 10$ V			5	V
g_{fs}	$I_D = 5.0$ A $V_{DS} = 10$ V	5.0			mhos
C_{iss} C_{oss} C_{rss}	$V_{DS} = 50$ V $V_{GS} = 0$ V $f = 1.0$ MHz		350 250 15		pF
G_{ps} η	$V_{DD} = 50$ V $I_{DQ} = 500$ mA $P_{out} = 300$ W $f = 175$ MHz	14 50	16 55		dB %
Ψ	$V_{SWR} = 5:1$ AT ALL PHASE ANGLES		NO DEGRADATION IN OUTPUT POWER		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for RF MOSFET Transistors category:

Click to view products by Advanced Semiconductor manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MRF492](#) [MRFE8VP8600HR5](#) [ARF1511](#) [ARF465BG](#) [BF 2030 E6814](#) [BLF861A](#) [MRF150J](#) [DU1215S](#) [DU28200M](#) [UF28100M](#) [DU2820S](#)
[MHT1008NT1](#) [MMRF1014NT1](#) [MRF426](#) [ARF468BG](#) [MAPHST0045](#) [MRFE6VP61K25NR6](#) [DU2860U](#) [VRF152GMP](#) [MRFE6VP5300NR1](#)
[BF2040E6814HTSA1](#) [MRFE6VP5150GNR1](#) [LET9060S](#) [MRF136Y](#) [BF999E6327HTSA1](#) [SD2931-12MR](#) [BF998E6327HTSA1](#)
[AFV10700HR5](#) [MRF141](#) [MRF171](#) [MRF172](#) [MRF174](#) [QPD1020SR](#) [BF 1005S E6327](#) [MRF134](#) [MRF136](#) [MRF137](#) [MRF141G](#) [MRF151](#)
[MRF151A](#) [MRF151G](#) [MRF157](#) [MRF158](#) [MRF160](#) [MRF171A](#) [MRF173](#) [MRF177](#) [UF2840G](#) [TGF3021-SM](#) [ARF1510](#)